

VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN

Abkürzungen, für die eine Definition vorliegt: siehe Begriffsbestimmungen

Abkürzungen	
ABEC	Qualitätsnorm des Verbandes der amerikanischen Wälzlagerhersteller (Annular Bearing Engineers Committee)
ADC	Analog-Digital-Wandler (Analogue-to-Digital Converter)
AGMA	Qualitätsnorm des Verbandes der amerikanischen Getriebehersteller (American Gear Manufacturers' Association)
AHRS	Lage- und Kurs-Referenzsystem (Attitude and Heading Reference Systems)
AISI	American Iron and Steel Institute
ALE	Atomlagenepitaxie (Atomic Layer Epitaxy)
ALU	Arithmetisch-logische Einheit (Arithmetic Logic Unit)
ANSI	American National Standards Institute
APP	Angepasste Spitzenleistung (Adjusted Peak Performance)
APU	Hilfstriebwerk (Auxiliary Power Unit)
ASTM	American Society for Testing and Materials
ATC	Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Control)
BJT	Bipolartransistor (Bipolar Junction Transistors)
BPP	Strahlparameterprodukt (Beam Parameter Product)
BSC	Base Station Controller
CAD	Rechnergestützter Entwurf (Computer-Aided-Design)
CAS	Chemical Abstracts Service
CCD	Ladungsgekoppeltes Bauelement (Charge Coupled Device)
CDU	Control and Display Unit
CEP	CEP-Wert (Circular Error Probable)
CMM	Koordinatenmessmaschine (Coordinate Measuring Machine)
CMOS	Komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Abkürzungen

CNTD	Thermische Zersetzung mit geregelter Keimbildung (Controlled Nucleation Thermal Deposition)
CPLD	Komplexer programmierbarer Logikschaltkreis (Complex Programmable Logic Device)
CPU	Zentraleinheit (Central Processing Unit)
CVD	Chemische Beschichtung aus der Gasphase (Chemical Vapour Deposition)
CW	Chemische Kampfstoffe (Chemical Warfare)
CW (für Laser)	Dauerstrich (Continous Wave)
DAC	Digital-Analog-Wandler (Digital-to-Analogue Converter)
DANL	Angezeigter mittlerer Rauschpegel (Displayed Average Noise Level)
DBRN	Datenbankgestütztes Navigationssystem (Data-Base Referenced Navigation)
DDS	Direkter digitaler Synthesizer (Direct Digital Synthesizer)
DMA	Dynamisch-mechanische Analyse
DME	Entfernungsmesseinrichtung (Distance Measuring Equipment)
DMOSFET	Diffundierter Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
DS	Gerichtete Erstarrung (Directionally Solidified)
EB	Brückenzünder (Exploding Bridge)
EB-PVD	Physikalische Beschichtung aus der Gasphase durch thermisches Verdampfen (Electron Beam Physical Vapour Deposition)
EBW	Brückenzünderdraht (Exploding bridge wire)
ECM	Elektrochemisches Abtragen (Electro-chemical machining)
EDM	Funkenerosionsmaschinen (Electrical Discharge Machines)
EEPROMS	Elektrisch programmierbarer und löschbarer Festwertspeicher (electrically erasable programmable read only memory)
EFI	Folienzünder (Exploding Foil Initiators)
EIRP	Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (Effective Isotropic Radiated Power)
ERF	Elektrorheologische Endbearbeitung (Electrorheological Finishing)
ERP	Effektive Strahlungsleistung (Effective Radiated Power)
ETO	ETO-Thyristor (Emitter-Turn-Off-Thyristor)
ETT	Elektrisch gesteuerter Thyristor (Electrical Triggering Thyristor)
FADEC	Volldigitale Triebwerksregelung (Full Authority Digital Engine Control)
FFT	Schnelle Fouriertransformation (Fast Fourier Transform)
FPGA	Field Programmable Gate Array
FPIC	Field Programmable Interconnect
FPLA	Field Programmable Logic Array
FPO	Gleitkomma-Operation (Floating Point Operation)
FWHM	Halbwertsbreite (Full-Width Half-Maximum)
GSM	Global System for Mobile Communications

Abkürzungen

GLONASS	Weltweites Satellitennavigationssystem (Global Navigation Satellite System)
GPS	Globales Positionierungssystem (Global Positioning System)
GNSS	Globales Satellitennavigationssystem (Global Navigation Satellite System)
GTO	GTO-Thyristor (Gate Turn-off Thyristor)
HBT	Hetero-Bipolartransistor (Hetero-Bipolar Transistors)
HEMT	Transistor auf der Basis hoher Elektronenbeweglichkeit (High Electron Mobility Transistors)
ICAO	Internationale Zivillufffahrt-Organisation (International Civil Aviation Organization)
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission (International Electrotechnical Commission)
IED	Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (Improvised Explosive Device)
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV	Momentaner Bildfeldwinkel (Instantaneous-Field-Of-View)
IGBT	Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (Insulated Gate Bipolar Transistor)
IGCT	IGC-Thyristor (Integrated Gate Commutated Thyristor)
IHO	International Hydrographic Organization
ILS	Instrumentenlandesystem (instrument landing system)
IMU	Trägheitsmessgerät (Inertial Measurement Unit)
INS	Trägheitsnavigationssystem (Inertial Navigation System)
IP	Internetprotokoll
IRS	Trägheitsreferenzsystem (Inertial Reference System)
IRU	Trägheitsreferenzgerät (Inertial Reference Unit)
ISA	Internationale Normatmosphäre (International Standard Atmosphere)
ISAR	Radar mit inverser künstlicher Apertur (Inverse Synthetic Aperture Radar)
ISO	Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization)
ITU	Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union)
JT	Joule-Thomson
KAS	Kleinste auflösbare Strukturweite (Minimum Resolvable Feature size)
LIDAR	Laser- oder Lichtradar (Light Detection and Ranging)
LIDT	Laserinduzierte Zerstörschwelle (Laser Induced Damage Threshold)
LOA	Länge über alles (Length Overall)
LRU	Auswechselbare Einheit (Line Replaceable Unit)
MLS	Mikrowellenlandesystem (Microwave Landing Systems)
MMIC	Monolithisch integrierte Mikrowellenschaltung (Monolithic Microwave Integrated Circuit)
MOCVD	CVD-Verfahren auf der Basis metallorganischer Verbindungen (Metal Organic Chemical Vapour Deposition)
MOSFET	Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)
MPM	Mikrowellenleistungsmodul (Microwave Power Module)

Abkürzungen

MRAM	Magnetischer Schreib-Lese-Speicher (Magnetic Random Access Memory)
MRF	Magnetorheologische Endbearbeitung (Magnetorheological Finishing)
MRI	Magnetresonanzbildgebung (Magnetic Resonance Imaging)
MTBF	Mittlere ausfallfreie Zeit (Mean Time Between Failures)
MTTF	Mittlere Zeit bis zum beobachteten Fehler (Mean Time To Failure)
NA	Numerische Apertur (Numerical Aperture)
NEQ	Nettoexplosivstoffmasse (Net Explosive Quantity)
OAM	Betrieb, Verwaltung oder Wartung (Operations, Administration or Maintenance)
OSI	Open Systems Interconnection
PAI	Polyamidimide (Polyamide-imides)
PAR	Präzisionsanflugradar (Precision Approach Radar)
PCL	Passives Lokalisierungssystem (Passive Coherent Location)
PIN	Persönliche Identifikationsnummer (Personal Identification Number)
PMR	Privater mobiler Sprechfunk (Private Mobile Radio)
PVD	Physikalische Beschichtung aus der Gasphase (Physical Vapour Deposition)
ppm	Entspricht 1×10^{-6} (parts per million)
QAM	Quadratur-Amplituden-Modulation (Quadrature-Amplitude-Modulation)
RAP	Reaktives Atomplasma (Reactive Atom Plasmas)
RF	Hochfrequenz (Radio Frequency)
RNC	Radio Network Controller
S-FIL	Nano-Imprint-Lithografie im Step-and-Flash-Imprint-Verfahren (Step and Flash Imprint Lithography)
SAR	Radar mit künstlicher Apertur (Synthetic Aperture Radar)
SAS	Sonar mit künstlicher Apertur (Synthetic Aperture Sonar)
SC	Einkristall [monokristallin] (Single Crystal)
SCR	Gesteuerter Silizium-Gleichrichter (Silicon Controlled Rectifier)
SFDR	Störungsfreier Dynamikbereich (Spurious Free Dynamic Range)
SHPL	Höchstleistungslaser (Super High Powered Laser)
SLAR	Seitensicht-Luftfahrzeug-Bordradarsystem (Sidelooking Airborne Radar)
SOI	Silizium-auf-Isolator (Silicon-on-Insulator)
SPLD	Einfacher programmierbarer Logikschaltkreis (Simple Programmable Logic Device)
SQUID	Supraleitende Quanteninterferenzeinheit (Superconducting Quantum Interference Device)
SRA	Auswechselbare Baugruppe (Shop Replaceable Assembly)

Abkürzungen

SRAM	Statischer Schreib-Lese-Speicher (Static Random Access Memory)
SSB	Einseitenband (Single Sideband)
SSR	Sekundärüberwachungsradar (Secondary Surveillance Radar)
SSS	Sonar mit seitlicher Abtastung (Side Scan Sonar)
TIR	Gesamtmessuhrausschlag (Total indicated reading)
TVR	Maximale Nennempfindlichkeit für Spannungspeisung (Transmitting Voltage Response)
UPR	Einseitige Wiederholgenauigkeit der Positionierung (Unidirectional Positioning Repeatability)
UV	ultraviolett
VJFET	Vertikal-Sperrschicht-Feldeffekttransistor (Vertical Junction Field Effect Transistor)
VOR	UKW-Drehfunkfeuer (Very High Frequency Omni-directional Range)
WLAN	Wireless Local Area Network